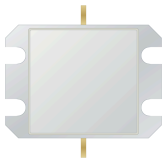
5700–7100 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 51 dBm (típico)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN Transistor de potencia con adaptación interna.



Valores de la tabla RF: PSAT 51 dBm (típico); Ganancia de potencia 11 dB (típico); PAE 45 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador.

Vg: C = 10 µF

Características RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	5700	-	7100	MHz
Potencia de salida saturada	-	50.5	51	-	dBm
Ganancia de potencia	-	10.5	11	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	-	40	45	-	%
Planitud de la ganancia de potencia	-	-	-	1.5	dB

Polarización DC y corrientes

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión de drenador en funcionamiento	-	-	-	-	28	V
Tensión de puerta en funcionamiento	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	-	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	-	-5	-	-	V
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Potencia de entrada máxima	-	-	-	42	dBm

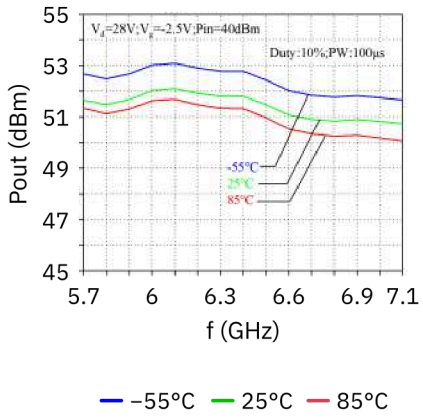
Registro de la publicación actual · 1.5 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.4.

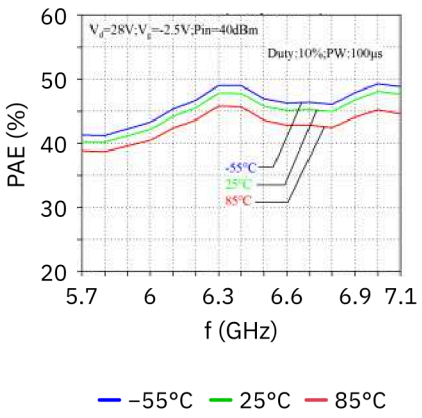
Notas de integración

CMW025B Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador. Vg: C = 10 µF G: Entrada RF D: Salida RF S: Fuente / tierra

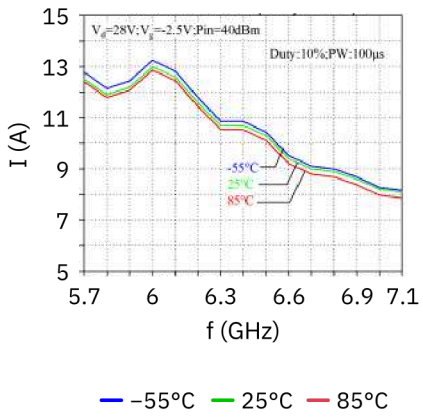
Curvas de rendimiento

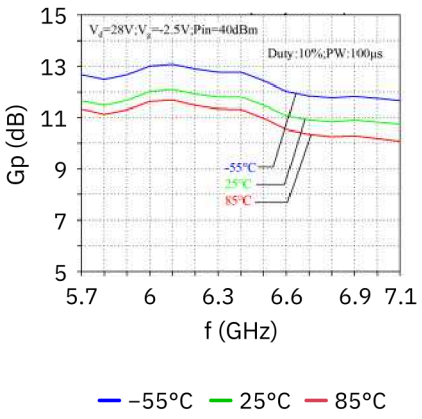
Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.



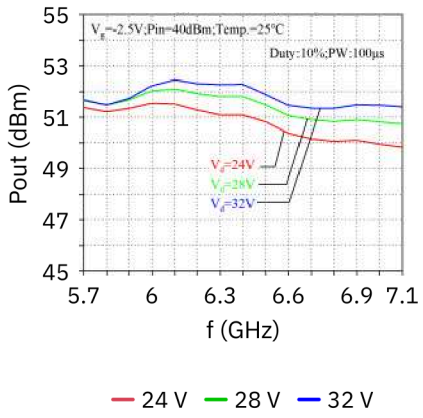


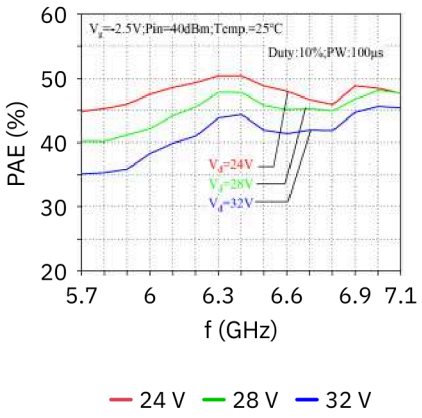
−55°C 25°C 85°C





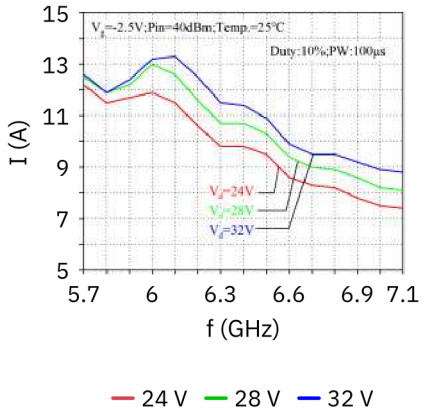
−55°C 25°C 85°C

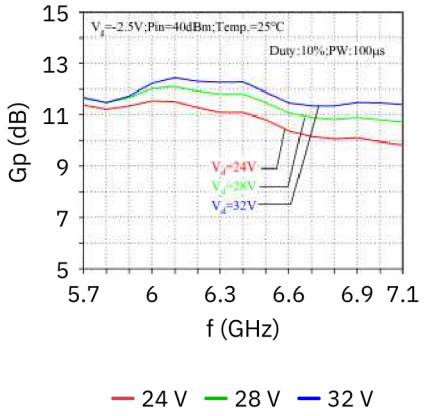


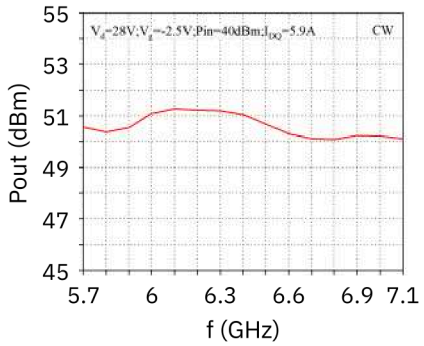


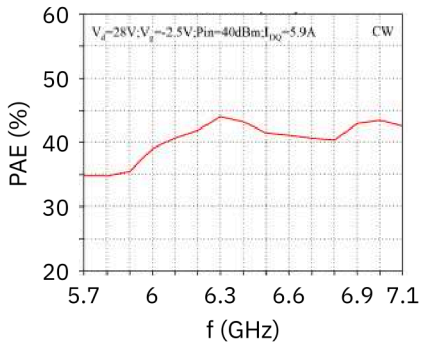
24 V 28 V 32 V

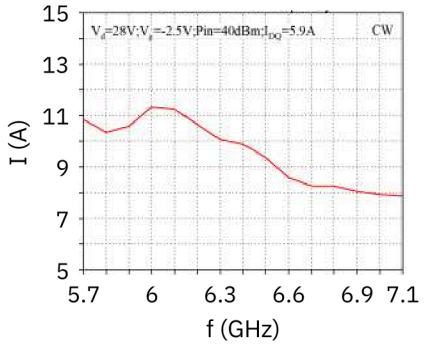
Potencia de salida; Eficiencia de potencia añadida; Corriente de drenador; Ganancia de potencia. Gráficos 1–4: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs; Temp = −55 / +25 / +85°C. Gráficos 5–6: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs.

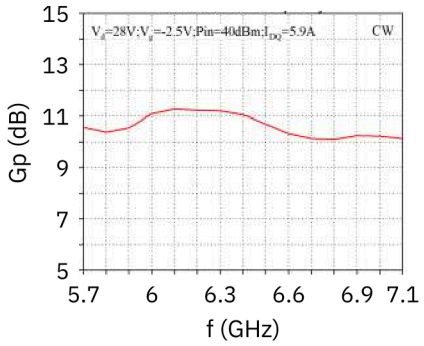




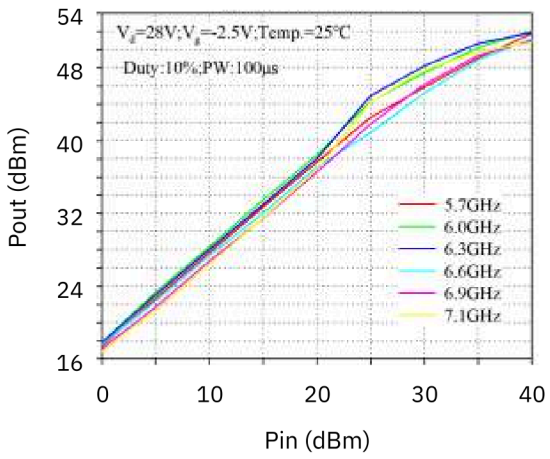


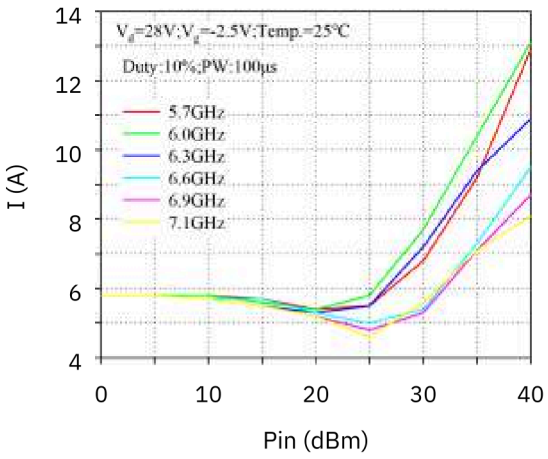






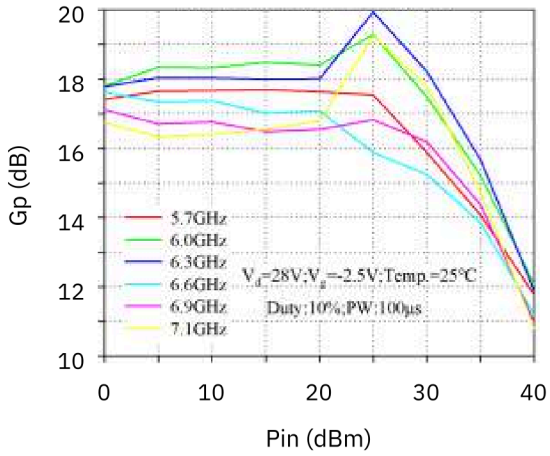
Potencia de salida; Eficiencia de potencia añadida; Corriente de drenador; Ganancia de potencia. Gráficos 1–2: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs. Gráficos 3–6: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

Potencia de salida; Corriente de drenador; Ganancia de potencia. Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.